

برآورد مقاومت ویژه لایه‌های سطحی زمین با استفاده از داده‌های الکترومغناطیسی هوابرد براساس مدل نیم‌فضا

فرزاد شیرزادی تبار^{۱*} و بهروز اسکویی^۲

^۱ دانشجوی دکتری زئوفیزیک، گروه فیزیک زمین، مؤسسه زئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران

^۲ استادیار، گروه فیزیک زمین، مؤسسه زئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران

(دریافت: ۹۰/۷/۱۹، پذیرش نهایی: ۹۰/۷/۱۰)

چکیده

بررسی‌های الکترومغناطیسی هوابرد به طور وسیعی برای به نقشه درآوردن اهداف زمین‌شناسی به کار می‌روند. کیفیت چنین نقشه‌هایی اگر داده‌های بسامدهای گوناگون استفاده شود بهتر خواهد بود. در اینجا مجموعه‌ای از داده‌های الکترومغناطیسی چندبسامدی به مجموعه‌ای از مقادیر مقاومت ویژه ظاهری و عمق مرکزی (عمقی) که بیشترین تجمع جریان القای حاصل از میدان اولیه در آنجا حضور دارد) تبدیل و به صورت منحنی‌های سوندazer رسم شده‌اند. این منحنی‌ها تصویری صاف از مقاومت ویژه عمودی به دست می‌دهند. در روش حاضر از یکتابع تبدیل C (یا عمق پوست تعیین یافته) برای یک سامانه دوقطبی با فاصله سیم‌پیچ‌های کوچک در ارتفاع معین از سطح زمین استفاده شده است. ویژگی این تابع این است که برای یک زمین لایه‌ای یا از نظر مقاومت ویژه الکتریکی یکنواخت، قسمت حقیقی آن، عمق مرکزی، و قسمت موهومی آن مقاومت ویژه ظاهری را برحسب توابعی از بسامد به دست می‌دهد. بنابراین با داشتن مقادیر مقاومت ویژه و عمق ظاهری برای بسامدهای گوناگون، می‌توان برآورده از تغییرات مقاومت ویژه با عمق را بدون داشتن یک مدل اولیه به دست آورد. اعمال این روش روی داده‌های مصنوعی متفاوت نشان می‌دهد که این روش فقط وجود تغییرات مقاومت ویژه را مشخص می‌کند اما مقادیر آن را بدست نمی‌دهد. همچنین این روش روی داده‌های واقعی در منطقه کلاته رشم در جنوب شرقی سمنان اعمال شد و مقاطع به دست آمده نشان می‌دهند که این روش بیشتر برای کارهای شناسایی کاربرد دارد و روش دقیقی نیست.

واژه‌های کلیدی: الکترومغناطیس هوابرد، مدل‌سازی پیشرو، مدل نیم‌فضا، مقاومت ویژه ظاهری

Approximate interpretation of Airborne Electromagnetic data using a half-space model

Shirzaditabar, F.¹ and Oskooi, B.²

¹ Ph. D. Student of Geophysics, Earth Physics Department, Institute of Geophysics, University of Tehran, Iran

² Assistant Professor, Earth Physics Department, Institute of Geophysics, University of Tehran, Iran

(Received: 26 Dec 2008, Accepted: 11 Oct 2011)

Abstract

When an alternating electromagnetic field propagates through the ground, it induces electric currents in any conductor in its path. The strength of the induced currents mainly depends on the electrical resistivity of the conductor concerned and the frequency with which the primary field is alternating. Generally speaking, the currents are stronger for smaller resistivity and higher frequency.

Airborne Electromagnetic (AEM) surveys can be used extensively for mapping and interpretation of geological targets. If the data were available for many frequencies, the resolution of such maps will be better.

With modern AEM equipment, the secondary magnetic field of the current induced in

the ground is measured at a rate of ten readings per second and for several frequencies simultaneously. The large amount of data collected during a survey must be converted into a set of apparent resistivity and centroid depth values which will provide at least a rough picture of the vertical resistivity distribution at each sampling point. The centroid depth for each frequency is an estimate of the depth in the half-space at which there is maximum induced current flow. This is the depth for which there will be maximum sensitivity to resistivity variations.

Here we have used a complex transfer function c (or generalized skin depth) derived from data for the secondary magnetic field measured by a dipole system with a small coil spacing "r" at a height "h" above the ground. It is known that the data measured above layered ground with AEM systems which satisfy $h \geq 3.3 r$, can generally be interpreted in terms of an equivalent half-space.

The complex transfer function 'c' has useful properties: for a uniform or layered ground, the real part of c yields the 'centroid depth' (z^*) and the imaginary part of c yields the apparent resistivity (ρ_a) as a function of frequency. So, if the function $\rho_a(z^*)$ is known over a broad frequency range, it yields a smoothed approximation of the true resistivity distribution $\rho(z)$ without an initial model. The relations between $\rho_a(z^*)$ and $\rho(z)$ are studied for a number of multilayer models. We also examine the method on real data which are collected over Kalat-e-Reshm area in southeast of Semnan province. Results show that the method can determine the existence of conductive and resistive structures but it cannot deliver detailed information about subsurface structure. Thus, it is recommended to use this method as a reconnaissance method not an exact detailed method.

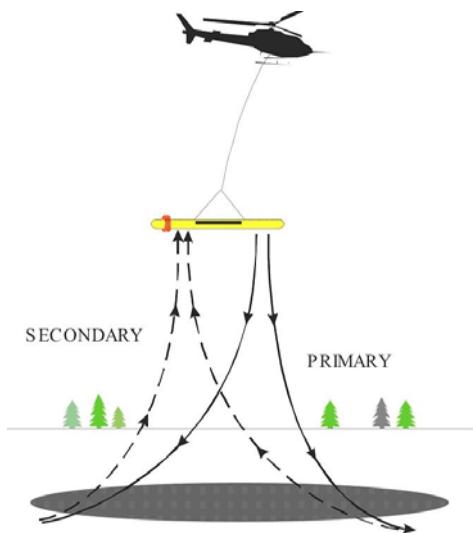
Key words: Airborne Electromagnetic, Forward modeling, Half-space model, Apparent resistivity

۱ مقدمه

زمینی و هوایبرد ساخته شده و به کار رفته است. شکل ۱ نمونه‌ای از روش برداشت داده‌های الکترومغناطیسی هوایبرد (Airborne Electromagnetic) را نشان می‌دهد. دستگاه‌های جدید اندازه‌گیری الکترومغناطیسی هوایبرد، میدان مغناطیسی ثانویه حاصل از القای جریان در لایه‌های زمین را با سرعت حدود ۱۰ داده در ثانیه و برای بسامدهای گوناگون به طور همزمان اندازه‌گیری می‌کنند. در هر پرواز تعداد داده‌های زیادی برداشت می‌شود که باید به پارامترهایی تبدیل شوند که حداقل بتوانند توزیعی تقریبی از تغییرات مقاومت ویژه با عمق را در هر نقطه مشخص کنند. بنابراین یک الگوریتم سریع و آسان برای عملی شدن این کار لازم است.

وقتی که یک میدان الکترومغناطیسی متناوب، که با کابل یا سیم پیچ حامل جریان متناوب تولید شده است، در درون زمین انتشار پیدا کند، در هر رسانایی که در مسیر ش باشد جریان‌های الکتریکی القا می‌کند. شدت این جریان‌های القا شده به مقاومت ویژه جسم رسانا و بسامدی که میدان اولیه با آن تولید شده بستگی دارد. شدت این جریان‌ها برای مقاومت ویژه کمتر و بسامد زیاد، بیشتر است.

در هر نقطه در محدوده میدان الکترومغناطیسی، میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی قابل اندازه‌گیری اند اما در روش الکترومغناطیسی هوایبرد عموماً میدان مغناطیسی اندازه‌گیری می‌شود. دستگاه‌های متعددی برای اندازه‌گیری میدان ثانویه به صورت



شکل ۱. نحوه برداشت داده‌های الکترومغناطیسی هوایی.

۲ محاسبه تبدیلات لازم برای استفاده از داده‌های الکترومغناطیسی هوایی

در اینجا برای استفاده از روابط مربوط به داده‌های الکترومغناطیس هوایی، یک مدل زمینی یک‌بعدی در نظر گرفته می‌شود و روابط برای یک سامانه با سیم‌پیچ‌های هم صفحه افقی (horizontal coplanar) بسط داده می‌شوند. شکل ۲ یک سامانه هم صفحه افقی را که روی یک مدل زمین یک‌بعدی قرار گرفته است نشان می‌دهد. در این شکل زمین به M لایه افقی تقسیم شده که تا بی‌نهایت ادامه دارند و رسانایی (عکس مقاومت ویژه) در لایه i آم برابر σ_i است ($\sigma_i = 1/\rho_i$). فاصله جدایی بین فرستنده و گیرنده و h_i ضخامت لایه i است. موج الکترومغناطیسی از یک جریان الکتریکی متناوب که در فرستنده جاری است ایجاد می‌شود و هم به صورت مستقیم، با نام میدان اولیه، هم بعد از القای جریان در لایه‌های زمین، با عنوان میدان ثانویه، به گیرنده می‌رسد. ویت (Wait) در ۱۹۸۲، نسبت میدان مغناطیسی ثانویه به اولیه حاصل از سیم‌پیچ هم صفحه افقی روی زمین لایه‌ای را به صورت زیر عرضه کرده است:

روشی که در اینجا از آن استفاده شده بر پایه مفهومی است که اشموکر (Schmucker) در ۱۹۷۰ برای معکوس کردن داده‌های مگنتوتلوریک (زمین‌مغناطیسی) از آن استفاده کرد. این مفهوم براساس قسمت‌های حقیقی و موهومی یکتابع تبدیل مختلط C_0 بنا شده است. وايدلت (Weidelt) در ۱۹۷۲ ثابت کرد که قسمت حقیقی تابع تبدیل C_0 معادل با عمقی است که بیشتر جریان القایی حاصل از میدان اولیه در آنجا وجود دارد. این عمق به عمق مرکزی (z_0^*) (centroid depth) معروف است. همچنین از قسمت موهومی تابع تبدیل C_0 می‌توان برای تعیین مقاومت ویژه محیط ρ_0^* در عمق مرکزی z_0^* استفاده کرد. در اندازه‌گیری روی یک زمین لایه‌ای و یا نیم‌فضا، تابع $(z_0^*) \rho_0^*$ تقریبی از توزیع مقاومت ویژه واقعی برحسب عمق به دست می‌دهد، مخصوصاً اگر لایه اول یک رسانای ضعیف باشد. این تابع تبدیل به صورت زیر داده شده است (وايدلت، ۱۹۷۲):

$$C_0 = \frac{\delta}{2} - i \frac{\delta}{2} \quad (1)$$

پس با محاسبه δ ، می‌توانیم به مقاومت ویژه ظاهری و عمق مرکزی دست پیدا کنیم.

$$\bar{R}_0(\bar{\lambda}) = \frac{\bar{\lambda} - \sqrt{\bar{\lambda}^2 + 2j\left(\frac{h}{\delta}\right)^2}}{\bar{\lambda} + \sqrt{\bar{\lambda}^2 + 2j\left(\frac{h}{\delta}\right)^2}} \quad (5)$$

در این صورت F فقط تابعی از $\frac{h}{\delta}$ خواهد بود؛ یعنی

$A = F\left(\frac{h}{\delta}\right)$. پس اندازه دامنه نسبی میدان ثانویه، A تقریباً برابر است با:

$$A = \left| \frac{H_s}{H_p} \right| \approx \left(\frac{r}{h} \right)^3 \cdot A^* \quad \text{که} \quad A^* = |F| \quad (6)$$

همچنین در تقریب اول، نسبت فاز (phase ratio) برابر است با:

$$\varepsilon = \frac{\text{Im}|A|}{\text{Re}|A|} \approx \frac{\text{Im}|F|}{\text{Re}|F|} \quad (7)$$

ε و A^* به فاصله بین سیم پیچ‌های گیرنده و فرستنده وابسته نیستند.

ماندrij (Mundry) در ۱۹۸۴ روابط تقریبی زیر را برای به دست آوردن نسبت $\frac{h}{\delta}$ و نیز دامنه A^* عرضه کرده است:

$$\frac{h}{\delta} \approx \varepsilon^{-1.23} \quad (8)$$

$$A^* \approx 0.065 \left(\frac{h}{\delta} \right)^{0.973 - 0.423 \log \left(\frac{h}{\delta} \right)} \quad (9)$$

بنابراین با دانستن h ، عمق پوست δ از نسبت $\frac{h}{\delta}$ قابل محاسبه است و برای مقاومت ویژه هم از رابطه

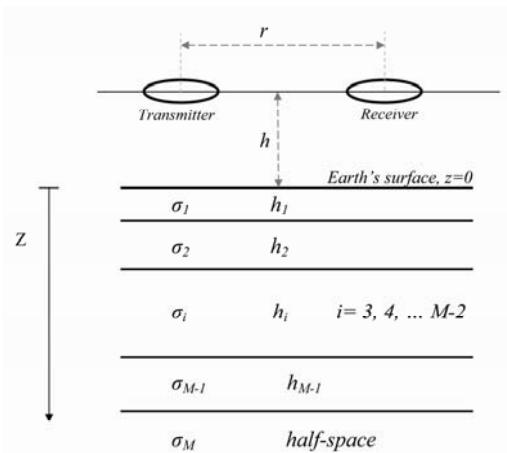
$$\delta = \sqrt{\frac{2\rho}{\omega\mu_0}} \quad \text{داریم:}$$

$$\rho_0^* = \frac{\omega\mu_0\delta^2}{2} \quad (10)$$

از طرف دیگر با توجه به رابطه (۱۰) می‌توان نوشت:

$$z_0^* = \frac{\delta}{2} \quad (11)$$

که



شکل ۲. هندسه سامانه هم صفحه افقی. سیم پیچ‌های فرستنده و گیرنده در ارتفاع h از سطح یک زمین یک‌بعدی قرار گرفته‌اند.

$$\frac{H_s}{H_p} = -r^3 \int_0^\infty R_0(\lambda) e^{-\lambda(2h)} J_0(\lambda r) \lambda^2 d\lambda \quad (2)$$

که در اینجا H_s میدان ثانویه، H_p میدان اولیه، h ارتفاع سامانه گیرنده-فرستنده از سطح زمین، r فاصله بین سیم پیچ‌ها، J_0 تابع بسل نوع اول مرتبه صفر و $R_0(\lambda)$ ضریب بازگشتشی موج الکترومغناطیسی از یک زمین لایه‌ای است که به صورت زیر بیان می‌شود:

$$R_0(\lambda) = \frac{N_0 - Y_1}{N_0 + Y_1} \quad (3)$$

که N_0 هدایت ظاهری (admittance) ذاتی برای هوای آزاد و Y_1 هدایت ظاهری کلی روی سطح است. سنگیل در ۱۹۸۸ ثابت کرد که داده‌های الکترومغناطیسی اندازه گیری شده روی زمین لایه‌ای با سامانه‌های هوایی در الکترومغناطیسی را، به شرطی که $d \geq \frac{3}{3} r$ باشد، می‌توان $h \geq \frac{3}{3} r$ براساس یک نیم فضای معادل تفسیر کرد. اگر $h \geq \frac{3}{3} r$ باشد می‌توان نوشت $A^* \approx J_0(\lambda r)$. حال با تغییر $\lambda \rightarrow \bar{\lambda}$ ، روابط (۲) و (۳) به صورت زیر نوشته می‌شوند:

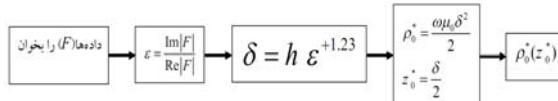
$$\frac{H_s}{H_p} \approx \left(\frac{r}{h} \right)^3 \cdot F \quad (4)$$

$$F = - \int_0^\infty \bar{\lambda}^2 \bar{R}_0(\bar{\lambda}) e^{-2\bar{\lambda}} d\bar{\lambda} \quad \text{که}$$

روی مدل‌های مصنوعی بررسی می‌کنیم. ابتدا از رابطه ۷، برای هریک از مدل‌های موردنظر در بسامدهای ۱۰، ۲۵، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰، ۸۰۰، ۱۶۰۰، ۳۲۰۰، ۶۴۰۰، ۱۲۸۰۰، ۲۵۶۰۰، ۵۱۲۰۰ هرتز داده مصنوعی می‌سازیم و در ادامه، این داده‌ها را با روابط به دست آمده براساس مدل نیم فضا، به توزیع مقاومت ویژه بر حسب عمق تبدیل می‌کنیم و توضیحاتی به دست می‌دهیم. با توجه به اینکه هر یک از بسامدها به عمق خاصی مربوط می‌شوند، هرچه تعداد بسامدها بیشتر باشد، مدل صاف‌تری به دست می‌آید. در همه مدل‌ها فاصله پیچه گیرنده و فرستنده (r) برابر ۸ متر و ارتفاع سامانه گیرنده-فرستنده از سطح (h) برابر ۳۰ متر در نظر گرفته شده است تا شرط $r \geq \frac{3}{2}h$ برای صحت روابط رعایت شده باشد. همچنین ضخامت لایه‌ها با افزایش عمق افزایش پیدا کرده است، به این علت که پاسخ الکترومغناطیسی لایه‌ها در اعمق بیشتر، کمتر می‌شود.

در شکل ۳-الف، یک مدل دو لایه بررسی شده است که لایه بالایی با ضخامت ۵۰ متر دارای مقاومت ویژه ۲۰ اهم متر و لایه پایینی نیم فضایی با مقاومت ویژه ۴۰ اهم متر است. می‌توان مشاهده کرد که مقدار مقاومت ویژه در سطح، نزدیک به واقعیت برآورد شده است و هرچه به مرز نزدیک می‌شویم به مقدار آن افزوده می‌شود. در عمق بیشتر هم مقدار مقاومت ویژه‌ی برآورد شده، به مقدار واقعی نزدیک‌تر می‌شود. شکل ۳-ب هم شرایط ۳-الف را دارد، با این تفاوت که در آن، لایه بالایی مقاومت ویژه ۴۰ و لایه پایینی مقاومت ویژه ۲۰ اهم متر دارد. در این مدل هم نتایج به دست آمده با مدل اولیه مشابه دارند. همچنین تجمع دایره‌ها در لایه اول، که نمایانگر مقاومت ویژه بر حسب عمق برای بسامدهای زیاد هستند، نشان می‌دهد که اثرات میدان مغناطیسی تولید شده در فرستنده در این بسامدها، به لایه دوم نرسیده است.

حال با داشتن داده‌های الکترومغناطیسی در بسامدهای گوناگون، می‌توان مقادیر مقاومت ویژه و عمق مرکزی را محاسبه کرد و در هر بسامد، مقاومت ویژه را به عمق مرکزی مربوط به آن اختصاص داد. به طور کلی می‌توان الگوریتم گردش کار را در هر بسامد به صورت زیر نشان داد:

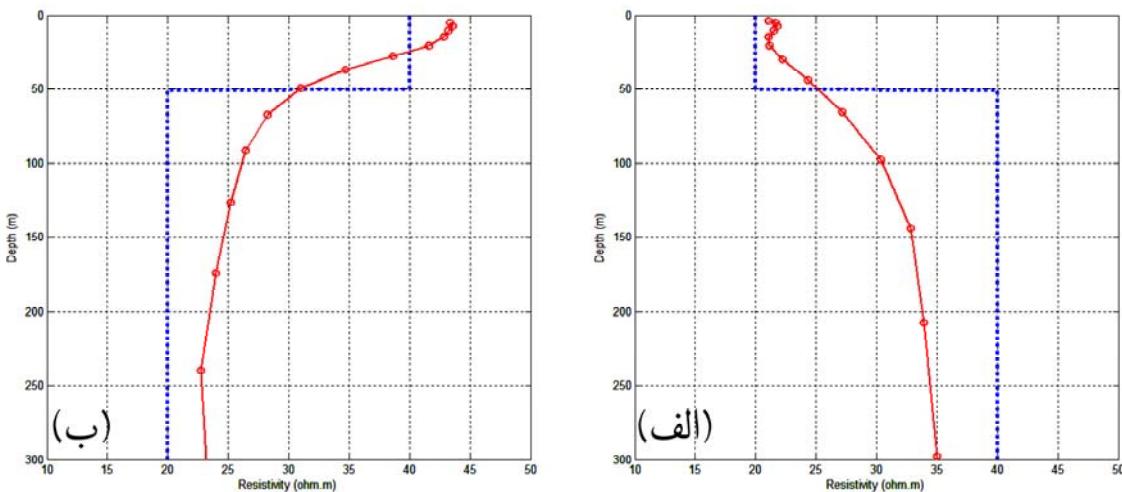


در نهایت می‌توان با رسم مقادیر (z_0^*) در هر نقطه برداشت، تصویری از تغییرات رسانایی، یا عکس آن مقاومت ویژه، با عمق به دست آورد. اگر این کار به طور پیوسته برای داده‌های برداشت شده از یک نیمرخ صورت گیرد، می‌توان مقطعی از تغییرات رسانایی با عمق را در آن نیمرخ مشخص کرد.

۳ بررسی محاسبات روی مدل‌های مصنوعی گوناگون

بهترین و دقیق‌ترین روش برای پی‌بردن به ساختار زیرسطحی استفاده از روش‌های معکوس‌سازی داده‌ها است. در این روش‌ها با داشتن مدل پیشرو، بازسازی داده‌ها آنقدر ادامه پیدا می‌کند که اختلاف بین داده‌های مشاهده شده و داده‌های ساخته شده از مدل پیشرو به حد قابل قبولی برسد. در این صورت پارامترهای مدلی که چنین داده‌هایی تولید کرده‌اند در حکم پارامترهای تعیین کننده ساختار زیرسطحی در نظر گرفته می‌شوند. کاربرد این روش به این علت که روابط مدل پیشرو پیچیده و تعداد تکرارها زیاد است، زمان زیادی لازم دارد. از طرفی در روش هوایرد، در هر پرواز تعداد داده‌های زیادی برداشت می‌شود که تبدیل این داده‌ها به پارامترهای مدل، کار بسیار وقت‌گیری است. از این‌رو از الگوریتم‌های سریع براساس مدل نیم فضا، حداقل برای به دست آوردن ساختار زیرسطحی تقریبی، استفاده می‌شود.

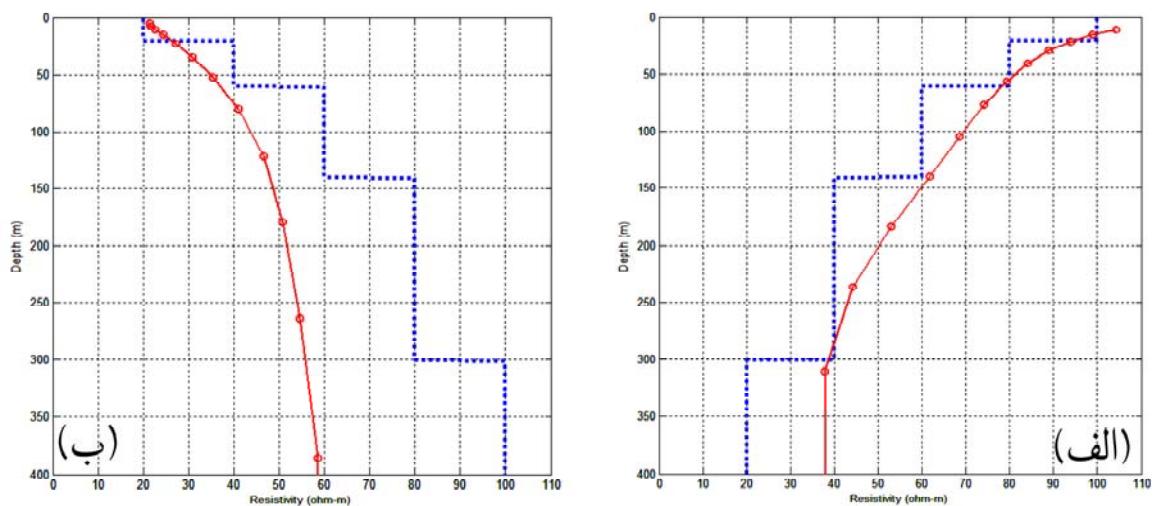
در این بخش صحت محاسبات ذکر شده در بالا را



شکل ۳. (الف) مدل زمین دو لایه (نقطه‌چین) که لایه بالای رساناتر است و (ب) مدل زمین دو لایه (نقطه‌چین) که لایه بالای مقاوم‌تر است و پاسخ الگوریتم داده شده به داده‌های تولید شده از این مدل‌ها (خط ممتد). دایره‌های مشخص شده نمایانگر عمق‌های مرکزی برای هر بسامد است.

این است که نتایج به دست آمده در شکل ۴-الف به مدل مصنوعی نزدیک‌تر است. علت این امر دو چیز است؛ یکی اینکه جریان الکتریکی القایی تمايل به شارش در لایه‌های با مقاومت ویژه کمتر دارد و دوم اینکه شدت سیگنال‌های الکترومغناطیسی با افزایش فاصله از فرستنده کاهش می‌یابد. از طرفی در لایه آخر که در عمق ۳۰۰ متری قرار دارد، مقاومت ویژه حالت ثابتی به خود گرفته که دلیل آن میراث دن امواج الکترومغناطیسی در لایه‌های بالاتر است.

حال فرض می‌کنیم که تغییرات مقاومت ویژه با عمق به صورت پیوسته کمتر یا بیشتر شود. شکل ۴ این وضعیت را نشان می‌دهد. در شکل ۴-الف مقدار مقاومت ویژه لایه‌ها با افزایش عمق کمتر شده است و منحنی به دست آمده هم این کاهش مقاومت ویژه با عمق را نشان می‌دهد. در شکل ۴-ب، بر خلاف شکل ۴-الف مقاومت ویژه لایه‌ها با افزایش عمق افزایش یافته است و منحنی مقاومت ویژه به دست آمده از مدل نیم‌فضا باز هم افزایش مقدار مقاومت ویژه با عمق را تشخیص داده است. اما نکته مهم

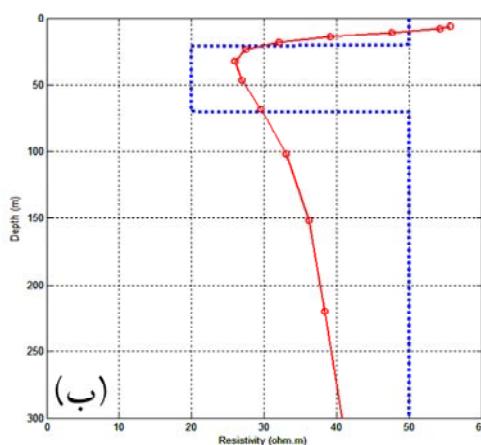


شکل ۴. مقاومت ویژه به طور پیوسته در (الف) کم و در (ب) زیاد می‌شود. خط‌چین‌ها مدل‌های اصلی و خطوط ممتد مدل‌های به دست آمده هستند.

به عمق برویم مقادیر مقاومت ویژه به مقادیر واقعی در آن عمق نزدیک‌تر می‌شود. به هر حال، هرچند که مقادیر مقاومت ویژه به درستی برآورده نشده است، اما هر دوی این منحنی‌ها وجود سه لایه را آشکار می‌کنند.

شکل ۶ هم مدل‌هایی را نشان می‌دهد که در آنها مقاومت ویژه لایه‌ها با عمق تغییر کرده است. در این شکل هم مقاومت ویژه لایه سوم که ضخامت ۶۰ متر دارد به درستی برآورده نشده اما برآورده مقاومت ویژه دیگر لایه‌ها به واقعیت نزدیک است.

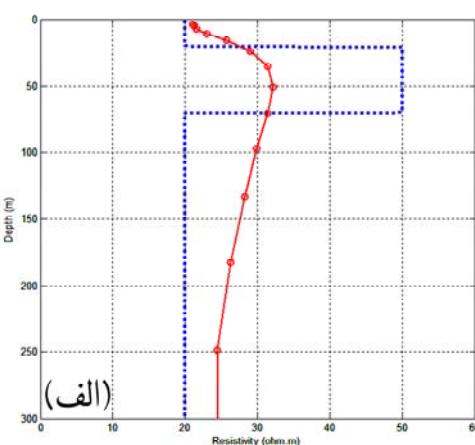
شکل ۷ تأثیر لایه رسانا بر عمق نفوذ موج الکترومغناطیسی را نشان می‌دهد. این شکل مانند شکل ۶-ب است که مقادیر مقاومت ویژه لایه سوم و لایه چهارم در آن برابر هستند. در عمق ۶۰۰ متری در شکل ۶-ب، مقاومت ویژه نزدیک ۱۰۰ اهمتر است درحالی که شکل ۷ مقاومت ویژه ۹۰ اهمتر را نشان می‌دهد. مقاومت ویژه سومین لایه هم به مقادیر اصلی نزدیک‌تر شده است. بنابراین هرچه ضخامت لایه رسانا بیشتر باشد، پاسخ الکترومغناطیسی آن بیشتر می‌شود. از سوی دیگر چون مقاومت ویژه لایه چهارم در مدل شکل ۷ به اندازه ۲۰ اهمتر کمتر شده است، میرایی سیگنال‌های الکترومغناطیسی بیشتر و همین امر باعث بیشتر منحرف شدن مقادیر مقاومت ویژه در لایه آخر شده است.



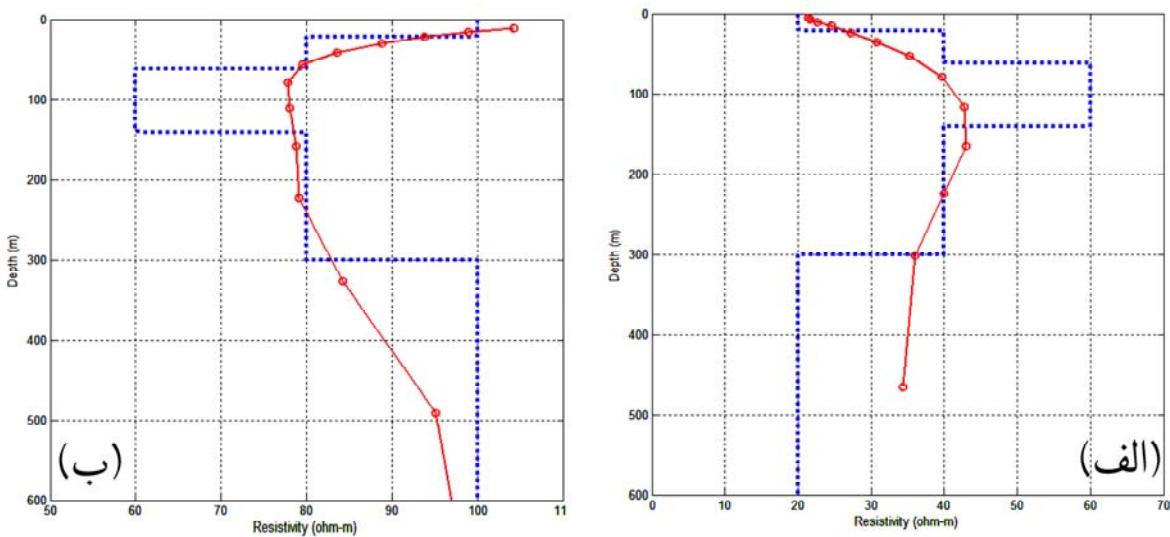
شکل ۵. (ب) مدل زمین سه لایه (نقطه‌چین) که لایه وسطی مقاوم‌تر است و (ب) مدل زمین سه لایه (نقطه‌چین) که لایه وسطی رساناتر است، به همراه پاسخ الگوریتم داده شده به داده‌های تولید شده از این مدل (خط ممتدا). دایره‌های مشخص شده نمایانگر عمق‌های مرکزی برای هر بسامد است.

شکل ۵-الف، مدلی سه لایه را نشان می‌دهد که در آن لایه با ضخامت ۲۰ متر و مقاومت ویژه ۲۰ اهمتر روی لایه‌ای با ضخامت ۵۰ متر و مقاومت ویژه ۵۰ اهمتر، روی نیم فضای ۲۰ اهمتری قرار گرفته‌اند. مقادیر مقاومت ویژه به دست آمده در لایه‌های اول و سوم بهتر از لایه دوم برآورده شده است؛ به این دلیل که جریان‌های الکتریکی بیشتر تمایل دارند که در محیط‌های رساناتر شارش پیدا کنند. از طرفی هم می‌توان مشاهده کرد که با وجود اینکه مقادیر مقاومت ویژه اول و سوم در مدل مصنوعی یکسان هستند، مقاومت ویژه لایه اول بهتر از لایه سوم بازیابی شده است چرا که لایه‌های بالایی نوعی اثر پوششی دارند، یعنی قسمت بیشتری از جریان القایی در آنها شارش پیدا می‌کند. بنابراین هرچه به عمق می‌رویم از شدت موج الکترومغناطیسی کاسته می‌شود. در هر صورت وجود لایه‌ای با مقاومت ویژه بیشتر در بین دو لایه دیگر مشخص است.

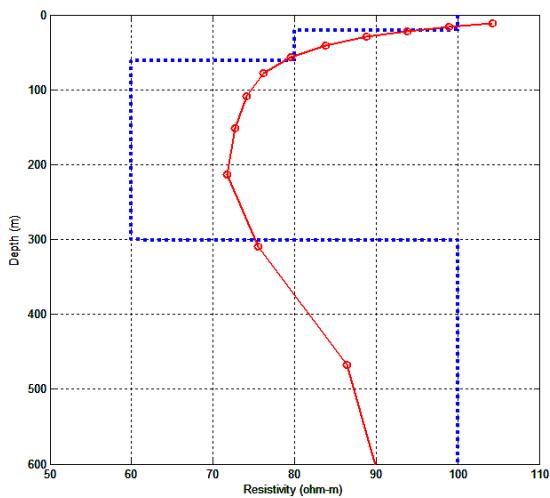
شکل ۵-ب هم مانند شکل ۵-الف، یک زمین سه لایه را نشان می‌دهد با این تفاوت که لایه دوم مقاومت ویژه ۲۰، و لایه‌های اول و سوم مقاومت ویژه ۵۰ اهمتر دارند. منحنی مقاومت ویژه به دست آمده نشان می‌دهد که مقادیر مقاومت ویژه لایه دوم به دلیل تجمع جریان‌های بیشتر در آن، نزدیک به واقعیت برآورده شده است. هرچه



شکل ۵. (الف) مدل زمین سه لایه (نقطه‌چین) که لایه وسطی مقاوم‌تر است و (الف) مدل زمین سه لایه (نقطه‌چین) که لایه وسطی رساناتر است، به همراه پاسخ الگوریتم داده شده به داده‌های تولید شده از این مدل (خط ممتدا). دایره‌های مشخص شده نمایانگر عمق‌های مرکزی برای هر بسامد است.



شکل ۶. مدل‌هایی که مقاومت ویژه در آنها با عمق افزایش و کاهش می‌یابد و بر عکس.



شکل ۷. شکل ۶-ب) برای زمانی که لایه چهارم هم مقاومت ویژه لایه سوم را دارد.

در منطقه مورد بررسی، که نقشه زمین‌شناسی آن در شکل ۸ نشان داده شده، یک رخ‌نمون مشخص به شکل کمان از جنس آندزیت پورفیری مشاهده می‌شود که قسمتی از آن در اثر فرسایش خود شده و قسمت‌هایی از آن با آبرفت پوشیده شده است. در قسمت بالا و درست چسبیده به این کمان، ساختار دیگری از جنس مارن به رنگ سبز تا کرم، ماسه‌سنگ، شیل و توف قرار دارد و می‌توان گفت مقداری از آبرفت‌هایی که کمان را پوشانده‌اند از همین ساختار هستند. هردوی این ساختارها

۴ مثال صحرایی

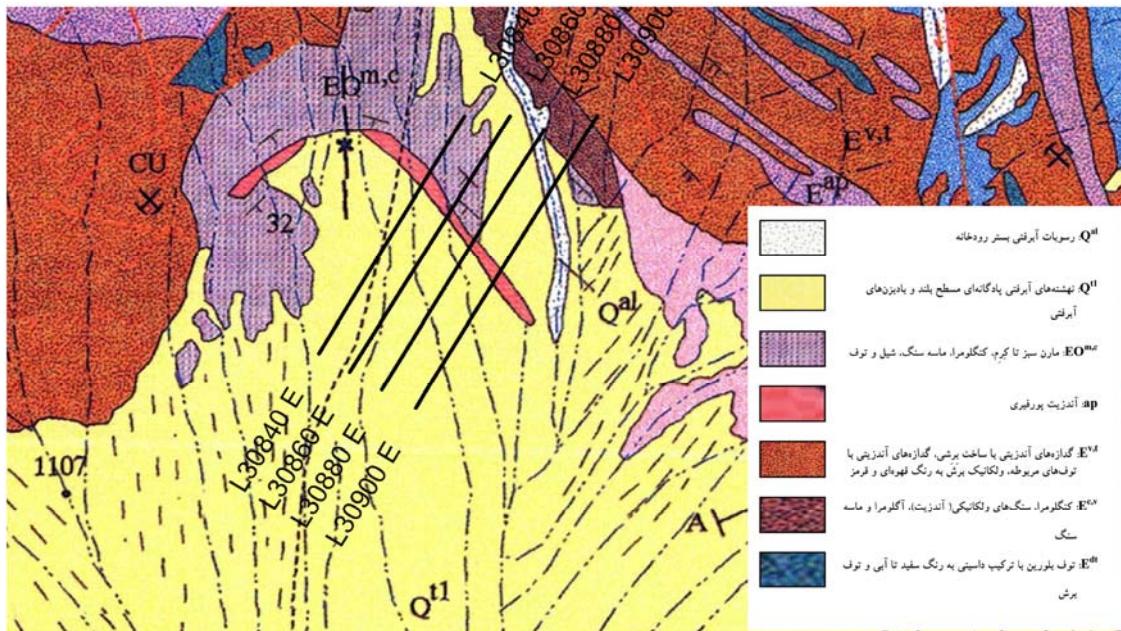
هدف ما در اینجا تبدیل داده‌های واقعی الکترومغناطیسی هوابرد به مقاطع مقاومت ویژه است. برای این منظور از داده‌های الکترومغناطیسی هوابرد که توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در منطقه کلاته رشم در جنوب شرقی سمنان برداشت شده‌اند استفاده می‌کنیم. دستگاه برداشت داده‌ها پنج بسامدی است که سه تا از این بسامدها، ۹۲۷، ۴۹۲۰ و ۳۳۰۰۰ هرتز، مربوط به سامانه هم صفحه افقی هستند.

آبرفت‌ها به شکل نهشته‌های آبرفتی پادگانه‌ای مسطح بلند و بادبزن‌های آبرفتی در روی کمان و در قسمت جنوبی آن جمع شده‌اند. پس می‌توان گفت که منطقه مورد بررسی پوشیده از آبرفت‌هایی شامل واحدهای تخریبی بالادرست از جنس ماسه‌سنگ، توف، کنگلومرا، واحدهای تخریبی آندزیتی و آتش‌شناختی و همچنین مارن و شیل است.

برداشت داده‌های هوابرد روی چندین خط در همین منطقه صورت گرفته است که در اینجا چهار خط با فاصله ۴۰۰ متری انتخاب شده است. مسیر این چهار خط روی نقشه زمین‌شناسی مشخص است.

شکل ۹ مقاطع به دست آمده از تبدیل داده‌های الکترومغناطیسی هوابرد روی چهار خط انتخاب شده را نشان می‌دهد. مقطع به دست آمده از خط شماره L30840، نشان می‌دهد. به طور واضح وجود یک ناحیه با مقاومت ویژه زیاد را تقریباً در مرکز نشان می‌دهد که این ناحیه رسانا در مقطع به دست آمده از خط شماره L30860، هم در مرکز قرار گرفته و هم عمق آن بیشتر شده است.

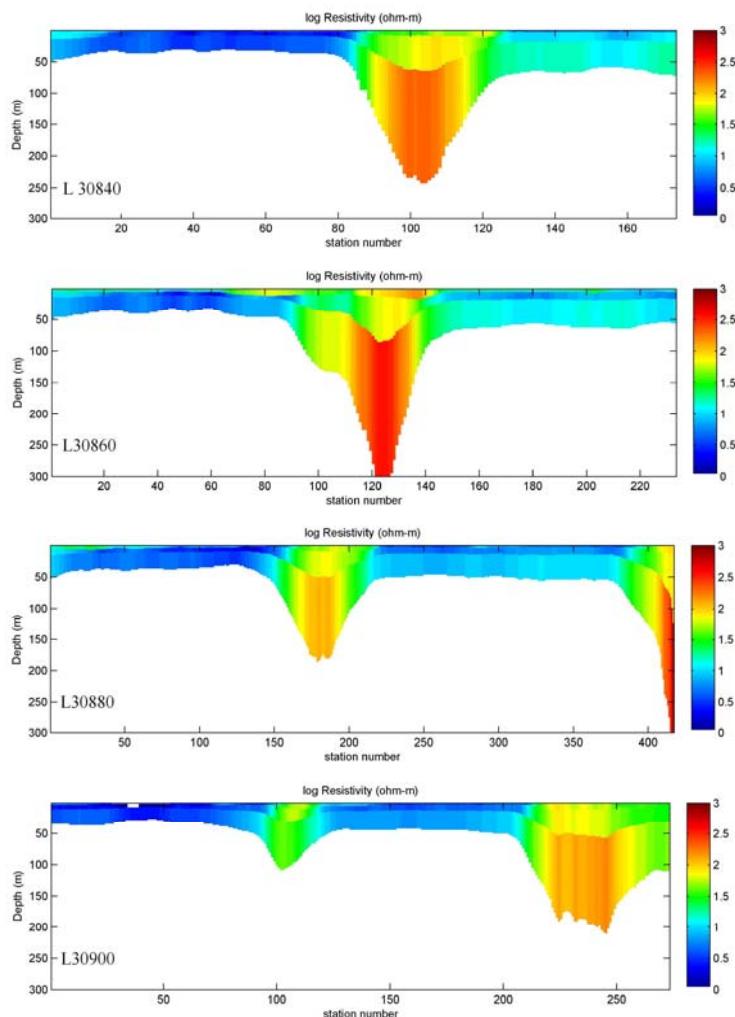
مربوط به دوره ترشیاری‌اند. این منطقه دارای توپوگرافی آرام است و از جنوب به شمال ارتفاع از سطح دریا به آرامی زیاد می‌شود. بنابراین بدیهی است که آبرفت‌های منطقه از جنس ساختارهای شمالی‌تر که در ارتفاع بالاتری قرار دارند باشد. اصلی‌ترین منشأ این آبرفت‌ها ساختاری شامل کلریت اپیدوت‌شیست، میکاشیست و کوارتزیت با رگه‌های سفید کوارتزی مربوط به دوره پالوزوویک و در شمال منطقه و همچنین ساختاری با توف‌های بلورین داسیتی سفید تا آبی و توف‌های بریشی مربوط به دوره سنوزوویک است. این آبرفت‌ها در مسیر خود از ساختارهای گدازه‌ای آندزیتی درشت بلور و یا با ساخت بریشی همراه با توف‌های مربوط به رنگ قهوه‌ای یا سرخ عبور می‌کنند و قسمتی از سنگ‌ها و خاک‌های این مناطق را با خود حمل می‌کنند. در بخش شمال شرقی هم آبرفت‌هایی با جنس توف، ماسه‌سنگ، کنگلومرا، شیست، میکاشیست، گدازه‌های آندزیت بازالتی، سنگ‌های اولترابازیک و مرمر که از ساختارهای متاولکانیک دوره پالوزوویک عبور می‌کنند، قرار دارند. درنهایت این



شکل ۸ نقشه زمین‌شناسی منطقه کلاته رشم، خطوط پرواز که از داده‌های آنها استفاده شده روی نقشه مشخص شده‌اند) برگرفته از نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰ منطقه کلاته رشم، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور).

L30900، عمق ناحیه مقاوم اول بسیار کم شده ولی ناحیه مقاوم دوم در سمت راست مقطع، بهتر مشخص شده است. مقایسه خطوط پرواز روی نقشه زمین‌شناسی و مقاطع مقاومت ویژه نشان می‌دهند که توده کمانی شکل از جنس آندزیت پورفیری و با مقاومت ویژه زیاد، پهن‌تر از آن چیزی است که در سطح زمین بیرون‌زدگی دارد. احتمالاً وجود آبرفت‌ها باعث پوشیده شدن قسمت‌هایی از این توده، مخصوصاً در قسمت‌های درونی کمان، شده است. همچنین عمق به دست آمده در مناطقی با مقاومت ویژه کم که با آبرفت پوشیده شده‌اند به حدود ۵۰ متر محدود شده است که این نشانگر کم شدن عمق نفوذ سیگنال‌های الکترومغناطیسی در این مناطق است.

این ناحیه مقاوم در هر دوی این مقاطع، همچنان‌که از نقشه زمین‌شناسی بر می‌آید، مربوط به وجود کمان از جنس آندزیت پورفیری است که مقاومت ویژه زیادی دارد و همچنین سمت چپ این مقاطع، که از جنس آبرفت است، دارای مقاومت ویژه الکتریکی کمتری نسبت به سمت راست آن، شامل توف، کنگلومرا، ماسه‌سنگ و شیل، است. در مقطع خط شماره L30880، این ناحیه مقاوم، هم به چپ متمایل شده و هم عمق آن کمتر شده است. از طرف دیگر در همین مقطع در انتهای سمت راست، ناحیه مقاوم دیگری تشخیص داده شده است که مربوط به آبرفت‌هایی از جنس گدازه‌های آندزیت- بازالی، شیست، مرمر و کوارتزیت است. در مقطع خط شماره



شکل ۹. مقاطع به دست آمده از تبدیل داده‌های الکترومغناطیسی هوابرد به مقاومت ویژه و عمق.

این لایه را براورد کند. از طرفی در لایه دوم به علت رساناتر بودن، مقاومت ویژه نسبتاً بهتر مشخص می‌شود. چنین مدل‌هایی در شکل ۳ نشان داده شده‌اند.

حال اگر با افزایش عمق مقاومت ویژه لایه‌ها کمتر شود، میدان مغناطیسی به لایه‌های پایین تر نفوذ می‌کند و در هر لایه جریان الکتریکی القا می‌شود که می‌تواند میدان مغناطیسی قابل ملاحظه‌ای را پدید آورد که منجر به تشخیص بهتر آن لایه شود. بر عکس اگر مقاومت ویژه با عمق افزایش پیدا کند آن‌گاه برآورد مقاومت ویژه واقعی از روی داده‌های به دست آمده بسیار مشکل خواهد بود (شکل ۴).

نکته مهم دیگر این است که جریان القایی در هر لایه، نه تنها به مقاومت ویژه، یا عکس آن رسانایی آن لایه بلکه به ضخامت آن نیز بستگی دارد. بر این اساس، واضح است که هرچه ضخامت لایه بیشتر باشد میزان جریان القایی در آن بیشتر خواهد بود. بنابراین اگر ضخامت لایه‌ای به اندازه کافی بزرگ باشد، آن لایه با بررسی‌های الکترومغناطیسی قابل تشخیص خواهد بود. این مطلب از مقایسه شکل ۶-ب با شکل ۷ قابل مشاهده است.

مطلوب مهم دیگر تعداد و مقدار بسامدهای مورد استفاده است. در اینجا ما از ۱۳ بسامد استفاده کرده‌ایم که محدوده بزرگی را در بر می‌گیرد و نتایجی که به دست آمده یک مدل صاف از تغییرات مقاومت ویژه را نشان داده است. اما در عمل چنین دستگاهی برای اندازه‌گیری هم زمان در ۱۳ بسامد وجود ندارد. آنچه در عمل صورت می‌گیرد اندازه‌گیری در حداقل ۵ بسامد است. این ۵ بسامد ممکن است در حالت نظری بتوانند با این روش یک زمین سه لایه را مدل‌سازی کنند اما در عمل با شکست مواجه می‌شوند. همان‌طور که به نظر می‌رسد در شکل ۶-الف حتی با ۱۳ بسامد توانسته‌ایم لایه‌های دوم و چهارم را تشخیص دهیم.

۵ بحث

فرایندی که در یک اندازه‌گیری الکترومغناطیسی هوایرد روی می‌دهد یک فرایند فیزیکی منطقی است. تغییرات میدان مغناطیسی حاصل از یک پیچه جریان متناوب (فرستنده) باعث القای جریان الکتریکی متناوب در توده‌های زیر سطحی می‌شود که مقدار این جریان به مقاومت ویژه این توده‌ها بستگی دارد. در ادامه این جریان القایی متناوب هم باعث ایجاد یک میدان مغناطیسی ثانویه می‌شود که این میدان ثانویه، به همراه میدان اولیه، در محل گیرنده اندازه‌گیری می‌شود. حال اگر فرض کنیم که پیچه فرستنده، مثلاً جریان ۱۰ آمپر را در زمین القا کرده باشد، و اگر یک زمین سه لایه فرض کنیم که در لایه اول آن ۶ آمپر و در لایه دوم حداقل ۴ آمپر جریان القا شده باشد، بنابر اصل بقای ارزی، در لایه سوم هیچ جریانی نخواهیم داشت. پس می‌توانیم بگوییم که عمقی که جریان‌های الکتریکی القایی در آنجا ایجاد می‌شوند، محدود است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه در اینجا زمین را برای هر بسامد به صورت نیم فضا در نظر گرفته‌ایم، می‌توانیم بگوییم که مقاومت ویژه به دست آمده در هر بسامد، یک مقاومت ویژه متوسط است. چون جریان‌ها در هر لایه به صورت افقی شارش پیدا می‌کنند می‌توان هر لایه را به صورت یک مقاومت الکتریکی در نظر گرفت که در مجموع، این لایه‌ها به صورت مقاومت‌های موازی عمل می‌کنند و یک مقاومت متوسط به دست می‌دهند.

حال فرض کنید یک لایه رسانا روی یک لایه مقاوم قرار گیرد. در این صورت جریان‌های القا شده در لایه رسانا بیشتر از لایه مقاوم خواهد بود و واضح است که تبدیل داده‌های حاصل از چنین مدلی نتیجه درستی برای مقاومت ویژه و عمق لایه مقاوم به دست نمی‌دهد. اما اگر حالت بر عکس این مدل را در نظر بگیریم که لایه دوم رساناتر است، هرچند که در لایه اول هم جریان القا می‌شود اما این جریان نمی‌تواند به درستی مقاومت ویژه

تشکر و قدردانی

نگارندگان بدین وسیله از مدیریت بخش ژئوفیزیک هوانی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و نیز کارمندان این بخش به خاطر در اختیار قرار دادن داده‌های الکترومغناطیس هوابرد و اطلاعات زمین‌شناسی سپاس‌گزاری می‌کنند.

منابع

- Mundry, E., 1984, On the interpretation of airborne electromagnetic data for the two-layer case, *Geophys. Prosp.*, **32**, 336–346.
- Schmucker, U., 1970, Anomalies of geomagnetic variations in the southwestern United States, *Bulletin of the Scripps Institution of Oceanography* 13. University of California.
- Sengpiel, K. P., 1988, Approximate inversion of airborne EM data from a multi-layered ground, *Geophys. Prosp.*, **36**, 446–459.
- Wait, J. R., 1982, *Geo-Electromagnetism*, Academic Press.
- Weidelt, P. 1972, The inverse problem of geomagnetic induction, *Zeitschrift für Geophysik*, **38**, 257-289.

۶ نتیجه‌گیری

در این تحقیق، یک زمین سه‌بعدی با ساختارهای پیچیده به صورت یک نیم‌فضا فرض شده است که از یک طرف باعث ساده شدن محاسبات و از طرف دیگر باعث از دست رفتن بعضی اطلاعات می‌شود. از جمله این اطلاعات قدرت تفکیک ساختارهای موجود در زمین است، طوری که مقادیر مقاومت ویژه برآورد شده مقادیر متوسط هستند. مقادیر مقاومت ویژه به دست آمده از داده‌های مصنوعی این مطلب را تأیید می‌کنند. از سوی دیگر در همه مدل‌های مصنوعی ساختارهای نزدیک سطح بهتر از ساختارهای عمیقی‌تر شناسایی شده‌اند که اولاً نشانگر افت شدت سیگنال‌های الکترومغناطیسی در عبور از لایه‌های زمین است و ثانیاً بیان می‌کند که پاسخ‌های به دست آمده در لایه سطحی، برای هردوی داده‌های مصنوعی و واقعی، قابل اعتمادتر هستند. بهر حال در همه مدل‌های مصنوعی، وجود تغییرات مقاومت ویژه مشخص شده است؛ هرچند که این مقادیر برآورد شده با مقادیر واقعی اختلاف زیادی دارند. اعمال این روش روی داده‌های واقعی هم، به خوبی وجود نواحی و ساختارهای با مقاومت ویژه زیاد را نشان می‌دهد؛ با این حال، در واقع فقط مقاومت ویژه لایه اول قابل اعتماد است. از طرف دیگر، از مقاطع به دست آمده می‌توان دریافت که هرجا مقاومت ویژه بیشتر شده است، توانسته‌ایم تا عمق بیشتری را به نقشه درآوریم که این دلیلی بر آن است که عمق نفوذ امواج الکترومغناطیسی با افزایش مقاومت ویژه افزایش می‌یابد.

درنهایت می‌توان گفت که استفاده از مدل نیم‌فضا در الکترومغناطیس هوابرد، مدل‌هایی را به دست می‌دهد که بیشتر برای تشخیص تغییرات مقاومت ویژه به کار می‌رود و نه مقدار دقیق آن. به تعبیر دیگر، بهتر است از این نتایج برای کارهای شناسایی استفاده شود و نه برای کارهای اکتشافی دقیق.